

半導体製造プロセスにおいて、材料表面の清浄化および改質は、デバイスの信頼性を確保する上で極めて重要な工程である。集積回路の微細化がサブ10 nmノードへ進行する一方で、一部の領域では新材料の導入と集積回路の三次元化積層化が進む。洗浄・ウェットプロセスにおいては、微細パターンのダメージレス処理と高品質化を両立しなければならない従来の難題に加え、新材料や3次元化に対応した新しい洗浄・ウェットプロセスの研究開発も急がれている。本シンポジウムでは、こういった多様化する半導体デバイスのニーズに合わせた新規なウェットプロセスに関する新しい研究結果について報告する場を提供する。

招待講演

9/19(木)
開催

- **原子レベル清浄表面の追求と新規なウェットエッチング**
有馬 健太(大阪大学)
- **電解を利用したIII-Vの表面洗浄**
佐藤 威友(北海道大学)
- **3Dフラッシュメモリ積層化に求められる新しいウェットプロセス**
吉水 康人(東芝メモリ)
- **物理洗浄の手法の多様化**
清家 善之(愛知工業大学)
- **DRAM製造プロセスにおける洗浄技術開発の取り組みと課題**
八木 秀明(マイクロンメモリジャパン)

本シンポジウムに関するお問い合わせ先
オルガノ株式会社 矢野大作(世話人)
yano-d@organo.co.jp

